

唁 电

中国科学院微电子研究所：

惊闻中国科学院院士，我国微电子领域早期开拓者之一，中国科学院微电子研究所研究员吴德馨先生不幸辞世，不胜哀悼！

吴德馨先生与中国科学院半导体研究所渊源深厚，半导体所是她科研生涯的起点与深耕之地。1961年，她怀揣着助力国家半导体事业起步的初心投身半导体所发展，自此扎根科研一线25载，成为半导体所初创与发展的核心力量，为半导体所的发展和我国半导体科技的发展奠定了坚实基础。上世纪60年代，她作为主要负责人之一，在国内率先研发出硅平面型高速开关晶体管，开关速度达到当时国际同类产品水平，为“两弹一星”功勋计算机109丙机提供了器件基础；成功研发介质隔离数字集成电路与高阻抗运算放大器模拟电路，有力支撑了我国国防工业的发展。70年代，她带领团队成功研制MOS 4K位动态随机存储器（DRAM）；在国内首次将正性胶光刻、干法刻蚀等先进工艺用于大规模集成电路研制，独创“露点法”检测接触孔质量，开发双层多晶硅与差值氧化工艺，大幅提升了大规模集成电路成品率；攻克16K、64K位DRAM技术，推动了我国存储器技术迭代升级。1966年，她与半导体所王圩先生结为伉俪、携手并进，后二人双双当选为院士，谱写了我国科技界一段相濡以沫、并肩报国的夫妻院士佳话。

吴德馨先生毕生将国家需求视为己任，将个人发展与国家战略紧密相连。1986年，因国家微电子事业发展布局需要，她调入新组建的中国科学院微电子中心，成为我国微电子科研机构建设与技术攻关的核心带头人。她主持多项国家级重大科研项目，带领团队自主研发3微米、0.8微米CMOS大规模集成电路全套工艺技术，攻克深亚微米器件、砷化镓微波器件、氮化镓功率器件等多项关键技术，研制出多款专用集成电路与新型半导体器件，相关成果多次荣获国家科技进步奖、中国科学院科技进步一等奖等重要奖项。

吴德馨先生的逝世不仅是中国科学院的重大损失，也是中国科技界的重大损失！她的爱国情怀与崇高风范，将激励我们敢为人先、勇毅前行，为国家半导体科技事业作出积极贡献。

先生虽逝，风范长存。吴德馨先生千古！

中国科学院半导体研究所

2026年3月23日

